

Кремниевый фотодетекторный чип 2.7×2.4 мм — техническое описание

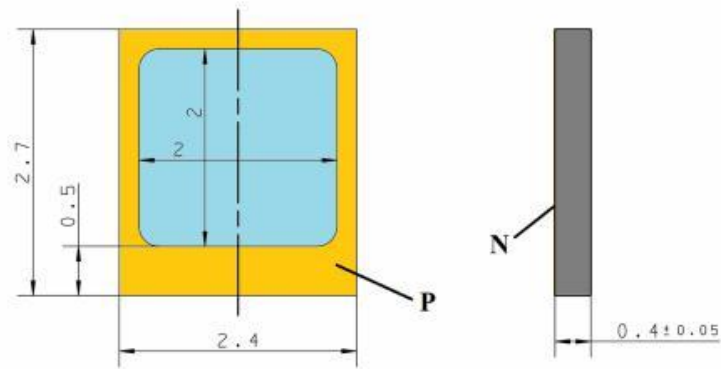
P/N : WS43-01B

Применение

Si PIN фотодиодный чип

Структура

Планарная структура: PIN-диод; электроды: задняя сторона (катод) — сплав Au, верхняя сторона (анод) — Au



ГАБАРИТЫ

Габариты	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Активная область	2000±30 x 2000±30			мкм
Ширина чипа	2400±30			мкм
Длина чипа	2700±30			мкм
Высота чипа	350	400	450	мкм

Электрооптические характеристики (при Ta=25 °C)

Параметр	Обозначение	Условия измерения	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Прямое напряжение	Vf	If=5mA, H=0	0.6		0.9	В
Обратный темновой ток	Id	Vr=10V			50	нА
Чувствительность	Re.	VR=10V, λ=795nm		0.52		А/Вт
Рабочий диапазон длин волн	λ		400		1100	нм
Емкость	Cj	VR=10V, f=1MHz			15	пФ